大学物理(II)复习

【静电场】:

静电场最基本的物理量是场强与电势,它们完全由电场本身决定,故在所有与静电场有关的问题中应该先求电场强度或者电势的分布,再求其他物理量!!

如电荷所受的电场力 $\bar{F} = q\bar{E}$

如在电场中移动电荷做功 $A_{ab} = q(U_a - U_b)$

一、主要掌握电势的定义以及相应的计算方法

①. 对于电荷分布高度对称的带电体 (电场强度易求), 用电势的定义式计算:

$$U_p = \int_p^{\text{s.s.}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

通常取无限远处(或地)为电势零点

电势差(电压)

$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

复习高斯定理的应用方法!(三种对称性的情况)

$$\iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{i} q_{i(\beta)}$$

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_{V} dq$$

$$E = egin{cases} rac{Q}{4\piarepsilon_0 r^2} & rac{1}{2\piarepsilon_0 r^2} & rac{\lambda}{2\piarepsilon_0 r} & rac{1}{2\piarepsilon_0 r} & rac{1$$

②.对于电荷分布非对称的带电体(电场强度不易求),用电势的叠加式计算

$$U_p = \int \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$
 重点关注其中 r 的物理含义

掌握三种电荷密度之间的换算! (方法是通过dq 的确定)

二、掌握已知电势与电场强度的相互关系

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} U = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right)$$

$$E_{x} = -\frac{\partial U}{\partial x} \qquad \qquad E_{y} = -\frac{\partial U}{\partial y} \qquad \qquad E_{z} = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

重点掌握已知 U(x,y,z) 求电场强度, 注意公式中的负号!

- 三、静电平衡下导体的性质
- 1. 导体内部场强为零 $E_{\rm h}=0$, $ar{E}$ 表面_\导体表面 $ar{E}_{\rm km}=rac{\sigma}{arepsilon_0}$
- 2. 电荷分布在导体表面上, 导体内部无电荷 $\sum q_{\Box} = 0$
- 3.导体是等势体,导体表面是等势面

利用上述条件, 求静电平衡时相应的电场强度与电势:

- ★注意: 首先要重新确定电荷的分布, 可利用电荷守恒 定律(导体不接地时)
- ★注意: 导体接地时是 U=0 (电量不一定等于零!),两导体相连时是 $U_1=U_2$
- ★注意: 导体附近有点电荷存在时,求感应电荷的方法, 是以对称中心的电势为参考, 叠加各部分电势, 通过电势关系求出感应电荷.

理解掌握书上例10.1和10.2

四、电容器的电容

重点掌握计算电容的基本步骤:

- 1. 先假设两极板分别带电+q、-q;
- 2. 用高斯定理求电场强度的分布;
- 3. 求两极板间的电势差;
- 4. 计算电容 $C = \frac{q}{U_A U_B}$

解题关键在于掌握各种电容器内部的电场强度分布

也可以记住常见的三种电容器的电容表达式,再通过串并联求解!

$$C = \varepsilon \frac{S}{d} \qquad C = \frac{2\pi\varepsilon l}{\ln(R_B/R_A)} \quad C = 4\pi\varepsilon \frac{R_A R_B}{R_B - R_A} \quad \sharp \psi \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

五、静电场中的电介质

了解电介质的极化过程及微观本质,重点掌握电介质中的高斯定理及应用方法!

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E}$$

$$\vec{D} = \vec{E} \cdot \vec{R} + \vec{E} = \vec{E} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E}$$

$$\vec{D} = \vec{E} \cdot \vec{R} + \vec{E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E}$$

$$\vec{D} = \vec{E} \cdot \vec{R} + \vec{E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E}$$

有电介质存在时解题均应先求D (D与电介质无关), 再求E 等其它物理量!!

灵活使用补偿或叠加原理.

复习巩固书上例10.5(及课件补充计算)和习题10.15。

六、计算电场能量的常用方法

$$w_{e} = \frac{1}{2}DE = \frac{1}{2}\varepsilon_{0}\varepsilon_{r}E^{2} = \frac{1}{2}\varepsilon E^{2}$$

$$W = \iiint_{V} w_{e} dV$$

$$dV = \begin{cases} 4\pi r^{2} \cdot dr \text{ (我)} \\ 2\pi rl \cdot dr \text{ (柱)} \\ S \cdot dr \text{ (板)} \end{cases}$$

电容器的能量:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$

★. 平行板电容器中 ε_r 、d 的变化, 讨论外力所做的功, 应分电源断开与不断开两种情况来讨论.

(复习课本例10.7、课件相关例题中电源不断开的情况)

【稳恒磁场】:

- 一、熟练掌握磁场分布(磁感应强度)的求解
 - 1、掌握电流的定义,确切理解电流元产生磁场的概念,掌握毕--萨定律及其应用

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \qquad \qquad \mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \mathrm{d}\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

运动电荷所产生的磁感应强度: $\bar{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \times r}{r^3}$

2、熟练应用安培环路定律求解电流分布具有高度对称性时的磁场分布

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i} I_{i}$$

注意I的正负与闭合回路环绕方向的关系

3、记住几种常见的磁场分布

(1). 有限长直载流导线的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$
 注意 θ_1 、 θ_2 的确定

无限长直导线:
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$
 半无限长直载流导线: $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

内:
$$B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$$

具体应用注意电流面密度的定义
$$\sigma = \frac{I_{\dot{\mathbb{B}}}}{S_{\perp}}$$

(2). 载流圆线圈轴线上的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$
 圆心处
$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

- 一段载流圆电流在圆心处的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{\theta}{2\pi}$
- (3). 无限长直螺线管的磁场 $B = \mu_0 nI$
- (4). 螺绕环内部的磁场

(5). 无限大载流平面

$$B = \frac{\mu_0}{2} j$$

- 4、熟练掌握利用磁场叠加原理求解磁感应强度
 - ★会用已知结果(特别是直线与圆组合)的叠加 (几种电流在同一点P的磁场叠加)

$$\vec{B}_P = \vec{B}_{1P} + \vec{B}_{2P} + \cdots$$

在应用已有结论时要特别注意公式的变形、电流元的选取. 载流圆线圈轴线上

如无限长直导线的:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \implies \mathrm{d}B = \frac{\mu_0 \mathrm{d}I}{2\pi r}$$

圆电流中心处

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r} \Longrightarrow dB = \frac{\mu_0 dI}{2r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I r^2}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} \Longrightarrow$$

$$dB = \frac{\mu_0 dI r^2}{2(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

运动电荷的等效电流换算法:

$$I=vq$$
或d $I=v$ d q , $v=\frac{\omega}{2\pi}$ 是转速

二、磁力、磁力矩

1. 洛仑兹力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

正确判断洛仑兹力的方向,与q的正负有关

2. 安培力 $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$ (其中**B**为外磁场) $\vec{F} = \int d\vec{F}$

叠加时先分解再合成 $\begin{cases} F_x = \int dF_x \\ F_y = \int dF_y \end{cases}$

3. 磁力矩

均匀磁场中的平面载流线圈所受的磁力矩为

$$\vec{M} = \vec{p}_{\scriptscriptstyle m} \times \vec{B}$$

其中 $\bar{p}_m = NIS \,\hat{\mathbf{n}}$ 为磁矩,S为线电流I包围的面积, 方向与电流方向成右手螺旋法则。

非均匀磁场中
$$\bar{M} = \int \vec{r} \times d\vec{F}$$

4. 磁力的功

$$A = I \Delta \Phi$$

- 三、带电粒子在磁场中的运动
 - 1、霍尔效应:

$$U_H = R_H \frac{IB}{h} \qquad \qquad R_H = \frac{1}{nq}$$

(注意霍尔电压的高低判断, 先确定所受磁力的方向. h是磁场方向的宽度)

2、带电粒子在均匀横向磁场中的匀速圆周运动:

$$qv_{\perp}B = \frac{mv_{\perp}^2}{R} \qquad \text{半径 } R = \frac{mv_{\perp}}{qB} \qquad \text{周期 } T = \frac{2\pi m}{qB}$$

四、静磁场中的磁介质

了解三类磁介质的磁化过程及微观本质,重点掌握磁介质中的安培环路定理及应用方法!

1、顺、抗磁质中B、H、M、 j_m 的计算

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1)\vec{H}$$

$$\vec{J}_m = M, I_m,$$

$$\vec{J}_m = \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum_{in} I_0$$

$$\vec{J}_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum_{in} I_m$$

有磁介质存在时解题均应先求H,再求B,M等 其它物理量!

2. 铁磁质:

了解铁磁质的特性及磁畴、剩磁、矫顽力、磁滞回线、居里点等概念。

14

棚中考试后

【电磁感应】 第十四章 电磁感应

- 一、理解产生感应电动势的条件及实验事实,理解产生感应电动势的非静电力及电动势的计算方法
 - 1、不论是动生电动势或感生电动势均可由 法拉第电磁感应定律求解

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

具体计算时也可先算出电动势的绝对值(必要时添加不产生附加电动势的辅助线),再用愣次定律判定方向.

【注意】: 关键是要有闭合回路或曲面来计算磁通量; 而且一定要求任一时刻的总磁通量 $\Phi_B(t)$, 才能用法拉第电磁感应定律求总感应电动势.

2、动生电动势

(1) 电动势定义
$$\vec{E}_K = \vec{v} \times \vec{B}$$
 $d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$
$$\varepsilon_i = \int_a^b \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

注意: 计算动生电动势时, 不要考虑磁场的变化!

3、感生电动势

- (1) 电动势定义
- ※.先求涡旋电场强度,再求感生电动势,这种方法仅适用于磁场分布具有高度对称性的情况;

磁场分布具有高度对称性的情况:(只有在载流密绕无限长圆柱内——柱对称均匀磁场下才可求出

涡旋电场强度)

$$\oint_{L} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{l} = -\iint_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$E_{i \bowtie} = -\frac{r}{2} \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \qquad (r \le R)$$

$$E_{i \not > h} = -\frac{R^2}{2r} \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \quad (r > R)$$

18

※. 再求感生电动势 $\varepsilon_{\text{\tiny d}} = \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

- (2) 法拉第电磁感应定律 构造闭合回路, 求总磁通量 $\boldsymbol{\Phi}_{\!B}(t)$, $\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\Phi}_{\!B}}{\mathrm{d}t}$
- 4、难点: 动生电动势、感生电动势同时存在的情况, 根据具体题目分开计算或直接应用法拉第电磁感应 定律一起求. 具体方法参阅课件相应内容.

- 二、掌握自感、互感系数的定义及计算方法
- 1. ★自感系数和自感电动势:

静态定义:
$$\Psi = LI$$
 (1)

动态定义:
$$\varepsilon_L = -L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$
 (2) $\varepsilon_L = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$

- a、利用定义计算自感系数的步骤与计算电容很类似:
 - (1). 假设线圈通有电流I;
 - (2). 求出磁场分布;
 - (3). 计算相应的磁通量—面元法向只能取一个方向
 - (4). 用 (1)式或(2)式求出L (I一定消去).

长直螺线管
$$L=\mu n^2 V$$

b、利用磁能计算自感系数

磁能:
$$W_{\rm m} = \frac{1}{2}LI^2$$
 $L = \frac{2W_{\rm m}}{I^2}$ 求L的另一种方法

2. ★互感系数

定义: $\Psi_2 = MI_1$ 或 $\Psi_1 = MI_2$

 $M_{21}=M_{12}=M$ 为计算 M 带来很大的灵活性

互感电动势: (1)
$$\varepsilon_2 = -M \frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}$$
 , $\varepsilon_1 = -M \frac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t}$

这种方法一般总是先求M后求 ε

互感电动势: (2)
$$\varepsilon_2 = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{B21}}{\mathrm{d}t}\Big|_{I_1}$$
, $\varepsilon_1 = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{B12}}{\mathrm{d}t}\Big|_{I_2}$

★计算互感系数的步骤:

- (1). 先在容易求出磁场分布的线圈中, 假设通电流I;
- (2). 求出相应的磁场分布;
- (3). 在另一个容易计算磁通量的回路中求互感磁通量——面元法向也只能取一个方向;
- (4). 用上述公式求出M (I一定消去).

三、磁场的能量

理解磁场能量的分布特点,掌握磁场能量的计算方法.

$$w_m = \frac{1}{2}BH$$

$$W_m = \frac{1}{2}BH \cdot V$$

$$W_m = \iiint_V w_m \cdot \mathrm{d}V$$

$$W_{\rm m} = \frac{1}{2}LI^2$$

【电磁场与电磁波】 第十五章 电磁场与电磁波

一. 位移电流 (与传导电流有何不同?)

位移电流
$$I_d = \frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t}$$
,位移电流密度 $\bar{j}_d = \frac{\mathrm{d}\bar{D}}{\mathrm{d}t}$

- ★ 重点掌握平行板电容器中j_D的计算.
 - ——注意位移电流是均匀分布在两极板之间

$$j_D = \frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{d} \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} \qquad I_d = j_D \cdot S$$

二. 全电流安培环路定理: (全电流是连续的)

$$\oint_{I} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I'_{d} \qquad I_{d}' = \pi r^{2} \cdot j_{D}$$

三、Maxwell方程组

★掌握积分形式及每个方程的物理意义

$$\oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{in} q = \iiint_{V} \rho dV$$

$$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_{m}}{dt} = -\iint_{S} \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{\text{in}} (I + I_{d}) = \iint_{S} \vec{j} \cdot d\vec{S} + \iint_{S} \frac{\partial D}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

四. 电磁波的性质(四条,详见教材P258,了解)横波、偏振、相位和数值关系、波速

$$\frac{E}{H} = \frac{E_0}{H_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \qquad v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}} \qquad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

五. 电磁波的能量

电磁场的总能量密度: $w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$

电磁波的能流密度——坡印廷矢量

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$$\vec{S} = \boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v} = \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{H}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0$$

复习巩固书上例15.2、习题15.14和课件相关例题

【波动光学】 第十六章 光的干涉

重点掌握光程差的定义,光程差与位相差的关系,熟悉掌握各类干涉的明纹(暗纹)条件、各个公式中k的取值与级数的关系,条纹移动的计算等.记住各种干涉装置的光路图.

首先找到干涉的两条光线,再计算它们到叠加点的光程差 $\delta=n_1r_1-n_2r_2$,同时考虑有无半波损失.

$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1 + \delta' = \begin{cases} \pm k\lambda &, k = 0, 1, 2, \dots$$
加强 (明纹)
$$\pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}, k = 0, 1, 2, \dots$$
减弱 (暗纹)

1、杨氏双缝干涉

$$\delta = d \sin \theta = \begin{cases} \pm k\lambda & k = 0,1,2,... 明 纹 \\ \pm (2k-1)\frac{\lambda}{2} & k = 1,2,3,... 暗 纹 \end{cases}$$

注: 为什么暗条纹条件不写为 $\pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ k = 0,1,2,...

零级条纹在光程差为零处,两侧是±1级,±2级,...条纹.相邻明条纹(或暗条纹)的间距为:

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{D}{d}\lambda$$
 近轴条件下: $d \cdot \sin \theta \approx d \frac{x}{D}$

条纹移动必然对应光程差的改变:

$$\Delta \delta = \delta_2 - \delta_1 = N\lambda$$

复习巩固习题16.3

2、薄膜干涉

- a、首先确定薄膜,找到哪两条光线干涉, 是反射光干涉还是透射光干涉;
- b、确定有无半波损失, 计算光程差;
- c、由明暗条纹的干涉条件,分析干涉条纹的特征.
- (1) 匀厚薄膜干涉 (等倾干涉)

干涉条纹:一系列明暗相间内疏外密的同心圆环,中央条纹级次最高.

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots 明 纹\\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots 暗 纹 \end{cases}$$

(2) 劈尖干涉 (等厚干涉)

干涉条纹:一系列与棱边平行的、明暗相间等距的直条纹.

$$\delta = 2ne + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k=1,2,3,...$$
明纹
$$\delta = 2ne + \delta' = \begin{cases} (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2,...$$
暗纹

相邻干涉条纹对应的薄膜厚度差: $\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$

干涉条纹间距:
$$\Delta l = \frac{\Delta e}{\sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$$

(3) 牛顿环 (等厚干涉)

干涉条纹:一系列明暗相间,内疏外密的同心圆环,中央条纹级次最低.

$$\delta = 2ne + (\frac{\lambda}{2}) = \begin{cases} k\lambda & k = 1,2,3,...$$
明纹
 $(2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0,1,2,...$ 暗纹

明环半径:
$$r = \sqrt{(k - \frac{1}{2}) \frac{R\lambda}{n}}$$
 , $k = 1, 2, 3, ...$

暗环半径:
$$r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$$
 , $k = 0,1,2,...$

注意其中几何关系 $e = \frac{r^2}{2R}$

注意牛顿环的变形

3、了解迈克耳孙干涉仪:结构、原理及应用

$$2d = \Delta N \cdot \lambda$$

或
$$2(n-1)d = \Delta N \cdot \lambda$$

求波长、或条纹移动的总数

- 4、干涉的应用:
 - (1) 测量细丝直径和微小厚度变化
 - (2) 检查表面质量等
 - (3) 增透膜

高反膜

$$\delta = 2n_2 e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$k=0,1,2,...$$

$$2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$
$$k = 1, 2, 3, \dots$$

复习巩固: 习题16.10, 16.15

第十七章 光的衍射

理解衍射角 θ 的含义及与总光程差、屏上位置的关系

1、单缝夫琅禾费衍射

(1) 明暗条纹的角位置: (应用半波带法)

(2) 明暗条纹的衍射屏上位置

 $x_k = f \cdot \tan \theta_k$, 当 $\theta \le 5$ °时, $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$

中央明纹宽度
$$\Delta x_{+} = \frac{2f\lambda}{a}$$
 其它明纹宽度 $\Delta x = \frac{f\lambda}{a}$

2、光栅衍射

光栅衍射的整个过程是平行光先经各个单缝衍射后, 再进行多光束干涉!

光栅的衍射条纹 = 单缝衍射 + 多光束干涉 掌握光栅常数的定义,理解 d=a+b 中各项的意义.

(1)、光栅衍射的条纹结构

光栅衍射条纹的明纹条件为: (光栅方程)

$$d\sin\theta = \pm k\lambda$$
; $k = 0,1,2,...$; 主极大

光栅衍射条纹的暗纹条件为:

$$Nd\sin\theta = \pm k'\lambda; \ k' = 1,2,..., k' \neq kN;$$
 极小

缺级条件:
$$d\sin\theta = k_2\lambda$$
 $\Rightarrow \frac{d}{a} = \frac{k_2}{k_1}$ 为整数比时,

满足
$$k_2 = \frac{d}{a}k_1$$
 为整数的主极大缺级

注意:

- (i) 单缝衍射条纹的明暗条件与干涉条纹的明暗条件 形式上相反,注意它们的区别、以及和光栅方程的区别.
- (ii) 单缝衍射和光栅衍射, 若光线垂直入射, 两侧条 纹对称分布.
 - (iii) 斜入射时的光栅方程

 $d(\sin \varphi + \sin \theta) = \pm k\lambda; k = 0,1,2,...;$ 主极大

 φ 和 θ 的符号规定:法线的同侧同号,异侧异号。

最大的改变是条纹不再对称分布,两侧 k_{max} 不同!

或 $d(\sin\theta \pm \sin\varphi) = \pm k\lambda$; k=0,1,2,...; 主极大

(2) 光栅的分辨本领 (分辨波长):

$$R_{\text{要求}} = \frac{\lambda}{\Lambda \lambda} \leq kN = R_{\text{达到}}$$
 复习巩固习题17.17

3、圆孔衍射:(记住公式,理解每个符号意义)

(1) 第一级暗环的角位置 $\theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

$$\theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

- (2) 爱里斑及瑞利判据
- (3) 光学仪器的最小分辨角与分辨本领(分辨细节):

$$\theta_{\min} = \theta_{1} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$\theta_{\min} = \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

4、X射线在晶体上的衍射:

布喇格方程:

$$2d\sin\theta = k\lambda;$$
 $k=1,2,...$

其中 θ 为掠射角

第十八章 光的偏振

主要了解光的五种偏振态,掌握各类偏振光的产生机理以及偏振片、波片的原理和作用。

1、马吕斯定律

$$I_{\text{dg}} = \frac{1}{2} I_{\text{hg}}$$
 $I_{\text{dg}} = I_{\text{hg}} \cos^2 \alpha$

2、布儒斯特定律

$$tgi_0 = \frac{n_2}{n_1} \qquad (光线由 n_1 入射到n_2)$$

$$\iff i_0 + \gamma = \frac{\pi}{2}$$

3、双折射现象

理解掌握双折射晶体的光轴、 o光、e光、 它们的主平面及相互关系, 1/2波片和1/4波片以 及它们的作用.

(1) 偏振片——尼科尔棱镜, 渥拉斯顿棱镜等

(2) 波晶片
$$\delta = |n_o - n_e| \cdot d$$
 $\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$
$$\frac{1}{2} ||h|| \cdot \delta = |(n_o - n_e)d| = \frac{\lambda}{2}$$

$$\frac{1}{4} ||h|| \cdot \delta = |(n_o - n_e)d| = \frac{\lambda}{4}$$
 (圆) 偏振光

(3) 会用简单的方法区分自然光、线偏振光及部分偏振光等

4、偏振光的干涉

分二种情形: o光与e光之间的关系

(i) 正交放置的两偏振片......

振幅关系

相位关系: 有附加
$$\pi$$
;
$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d + \pi$$

(ii) 平行放置的两偏振片

振幅关系

相位关系: 无附加
$$\pi$$
. $\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d$

(iii) 干涉结果: 相强干涉、相消干涉

【几何光学】

第十九 几何光学

- 一、符号规则
- 二、反射成像

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R}$$

成像公式、焦距

三、单球面折射成像公式

$$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$

$$f = f_1 = f_2 = \left[\frac{n - n_0}{n_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \right]^{-1}$$

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$$

五、光学器件

放大镜 显微镜 望远镜 放大率公式

【量子物理】

第二十章 电磁辐射的量子性

1、黑体辐射:

了解曲线图含义,分清总辐出度与功率的区别及联系. 掌握两条基本定律及T、 λ_m 、E 三者变化关系

$$M_B(T) = \sigma T^4$$
 $T\lambda_m = b$

2、光电效应:

(1) 实验规律:
$$eU_a = E_{km} = \frac{1}{2} m v_{\text{max}}^2$$
 红限 $A = h v_0 = h \frac{c}{\lambda_0}$

- (2) 光子理论: 光子能量, 光的强度 $I = Nh\nu$
- (3) 爱因斯坦方程及各种有关的物理概念

$$h v = E_{km} + A = \frac{1}{2} m v_m^2 + A$$

3、康普顿散射:

$$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi) = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$
其中 $\lambda_C = \frac{h}{m_0 c} = 0.00243 \text{ nm}$

- (1) 能量守恒
- (2) 动量守恒, 动量为矢量
- (3) 考虑相对论效应

4、光的波粒二象性

$$E = h v = mc^2 = E_k$$
 $m = \frac{h v}{c^2} = \frac{h}{\lambda c}$ $p = mc = \frac{h v}{c} = \frac{h}{\lambda}$

复习巩固例20.1、习题20.5、20.7

第二十一章 量子力学简介

1、德布罗意波、波粒二象性:

区分对比光子和实物粒子(如电子)的不同之处

要物粒子
$$E = mc^2 = hv \qquad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$$p = mv = \frac{h}{\lambda} \qquad (v \neq \lambda v)$$

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2$$

$$E^2 = p^2 c^2 + (m_0 c^2)^2$$

当
$$v << c$$
 时, $E_k = mc^2 - m_0c^2 \approx \frac{1}{2}m_0v^2 = \frac{p^2}{2m_0}$, $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0v}$

注意:实物粒子的动量、<u>动能</u>、总能量的区分.

2、不确定关系:

同一方向上粒子的位置和动量不能同时确定等! 能估算有关物理量

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \ge \frac{\hbar}{2} \qquad \qquad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

对物质波 (包括光波)
$$p = \frac{h}{\lambda}$$
 $\Delta p = \frac{h}{\lambda^2} \cdot \Delta \lambda$

复习巩固习题21.2、习题21.13

3、波函数及其统计意义

一维定态波函数φ的含义:

概率密度: $f_P(x) = |\varphi(x)|^2 = \varphi(x) \cdot \varphi^*(x)$

在dx范围内粒子出现的概率为 $|\varphi(x)|^2 dx$

- (1)波函数的标准化条件:单值、连续、有限
- (2) 波函数的归一化条件→定常数A: $\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(x)|^2 \cdot dx = 1$

在已知波函数的情况下,会计算

- (a) 空间某处的概率密度;
- (b) 概率密度最大值处;
- (c) 某范围内出现的概率等.

4、定态薛定谔方程与一维无限深势阱 $(0 \le x \le a)$

(1)、能量量子化

零点能

(2)、归一化波函数

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{n\pi}{a}x) \quad (0 \le x \le a) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

(4)、概率密度及极大、极小值

$$f_P(x) = |\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a}\sin^2(\frac{n\pi}{a}x) \quad (0 \le x \le a)$$

(5)、概率

$$\mathbf{x} \sim \mathbf{x} + \mathbf{d}\mathbf{x}$$
 区间概率
$$dP = |\psi(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \sin^2(\frac{n\pi}{a}x) dx$$

$$x_1 \sim x_2$$
 区间概率
$$P = \int_{x_1}^{x_2} |\psi(x)|^2 dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{2}{a} \sin^2(\frac{n\pi}{a}x) dx$$

第二十二章 氢原子及原子结构初步

1、氢光谱的规律

计算氢原子光谱的波长尽量用:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \qquad k=1, 2, 3, \dots; \\ n = k+1, k+2, k+3, \dots$$

$$k$$
决定线系, $k=1$ ——赖曼系 (紫外), $k=2$ ——巴尔末系, $k=3$ ——帕邢系 (红外)

2、玻尔氢原子理论

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV} , n=1, 2, 3, ...$$

 $r_n = n^2 r_1, n=1, 2, 3, ...$
 $h v = \frac{hc}{2} = (E_n - E_k)$

如何求电离能? 氢光谱如何区分线系? 每个线系的最短波长与最长波长如何确定?

熟练掌握跃迁图! 能求先到达某个最高能级 n_{max} ,再向下跃迁等问题.

复习巩固书上习题22.2

3、氢原子的量子力学描述

(1)、四个量子数与能量、角动量及其空间量子化

(i) 主量子数
$$n$$
 $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}, n=1, 2, 3, ...$

(ii) 角量子数
$$l$$
 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, $l=0,1,2,...,n-1$

(iii) 磁量子数
$$m_l$$
 $L_z = m_l \hbar$, $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, ..., \pm l$

(iv) 自旋磁量子数 m_s

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \sqrt{\frac{3}{4}}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$$
 $S_Z = m_s\hbar = \pm \frac{1}{2}\hbar$

- (2)掌握量子力学下氢原子及多电子原子 (n, l, m_l, m_s)
 - (a) 四个量子数的物理意义、相互关系及确定方法
 - (b) 四个量子数确定电子能量、角动量L、 L_Z , 和 θ ,
- (c) 某一能级可容纳的最多电子数为2n²个, 某一支壳层可容纳的最多电子数为2(2*l*+1)个.
 - (d) 玻尔理论和量子力学关于氢原子角动量量子化的区别

玻尔理论
$$L = mvr = n\hbar$$
, $n=1,2,3,...$ 量子力学 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, $l=0,1,2,3,...,n-1$

(3)、氢原子的波函数和概率分布

注意掌握核外电子的径向概率密度:

$$P(r) = r^2 \left| R_{nl}(r) \right|^2$$

复习巩固书上习题22.13

第二十三章 激光和固体的能带结构

- 1、掌握激光的产生条件和基本特点
 - (1). 激光的产生条件:
 - (a) 粒子数反转 (实现受激辐射)
 - (b) 光放大 (光学谐振腔)
 - (2). 激光的基本特性:
 - (a) 方向性好
- (b) 亮度高
- (c) 单色性好
- (d) 相干性好

- (3). 激光的分类:
- 2、固体的能带结构

掌握导体、半导体、绝缘体的能带特征,重点把握掺杂半导体 (p型、n型半导体) 的能带特征、p-n结伏安特性曲线。

注意掌握禁带宽度与外加光子能量之间的关系:

大学物理(II)复习特束